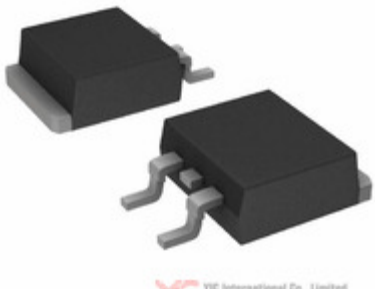





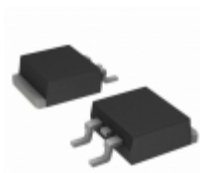




	<h2 style="color: #e67e22;">IPB65R099C6ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB65R099C6ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 38A TO263
Datenblätter:	 IPB65R099C6ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R099C6ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 38A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 12.8A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2780pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	127nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

IPB65R099C6ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB65R099C6ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB65R099C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB65R099C6ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB65R095C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R099C6 INFINEON IPB65R099C6 INFINEON</p>	 <p>IPB65R095C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R065C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB65R110CFDAATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R110CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 31.2A TO263</p>	 <p>IPB65R125C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R110CFD Infineon Technologies IPB65R110CFD Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB65R099C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB65R099C6ATMA1 Datenblatt	IPB65R099C6ATMA1-Datenblätter	IPB65R099C6ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R099C6ATMA1
IPB65R099C6ATMA1 Electronic	IPB65R099C6ATMA1-Komponenten	IPB65R099C6ATMA1-Verteiler	IPB65R099C6ATMA1-Bild	IPB65R099C6ATMA1-Teil
IPB65R099C6ATMA1 Preis	IPB65R099C6ATMA1 Hersteller	IPB65R099C6ATMA1 Bild	IPB65R099C6ATMA1 Aktie	IPB65R099C6ATMA1 Inventar
IPB65R099C6ATMA1 Neu	IPB65R099C6ATMA1 Original	IPB65R099C6ATMA1 garantiert	IPB65R099C6ATMA1 RFQ	IPB65R099C6ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited